Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0403U002655

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-07-2003

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ніцук Юрій Андрійович

2. Nitsuk Yurij Andrijovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-06-2003

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: 65082. м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 41.051.01

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: вул. Дворянська 2, м. Одеса, Одеська обл., 65058, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: 65082. м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Вплив власних і домішкових дефектів на електрофізичні та оптичні властивості монокристалів ZnSe:In, отриманих методом вільного росту.

2. Influence of native and impurity defects on electrophysical and optical properties of ZnSe:In single crystals, obtained by free growth method.

Реферат/анотація:

1. Об'єкт - процеси електропровідності, оптичного поглинання, люмінесценції і фотопровідності в монокристалах ZnSe, легованих індієм в процесі їх вирощування.; мета - з'ясування природи власних і домішкових центрів, що визначають фізичні властивості монокристалів ZnSe:In, отриманих методом вільного росту; методи - дослідження ефекту Холу; спектрів фотолюмінесценції, оптичного поглинання і фотопровідності; новизна - визначено природу центрів, які визначають фізичні властивості монокристалів ZnSe:In, отриманих методом вільного росту; вперше встановлено утворення міжвузловинних донорних центрів індію в n-ZnSe:In і акцепторних центрів у кристалах p-ZnSe:In; результати-одержано високопро-відні кристали ZnSe:In n- і p-типу провідності, які володіють ефективною блакитною люмінесценцією; галузь-фізика напів-провідників і діелектриків

2. Object - processes of an electrical conductivity, optical absorption, luminescence and photoconductivity in ZnSe single crystals, doped by indium during their growth; the purpose - clearing up of a nature of native and impurity centers, defining physical properties of ZnSe:In single crystals, obtained by free growth; methods - in-vestigation of a Hall effect; luminescence, optical absorption, pho-toconductivity spectra; the new approach lies in first developing of nature of centers, defining physical properties of ZnSe:In single crystals, obtained by free growth method. Formation of interstitial donor centers of indium in n-ZnSe:In and acceptor centers in crystals p-ZnSe:In for the first time are obtained; results - the procedure of deriving of high-conductivity crystals ZnSe:In n- and p-type conductance possessing an effective blue luminescence de-signed; the field - physics of semiconductors and dielectrics.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ваксман Юрій Федорович

2. Vaksman Yurij Fedorovych

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пташенко Олександр Олександрович;

2. Пташенко Олександр Олександрович;

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козицький Сергій Васильович;

2. Козицький Сергій Васильович;

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Сминтина Валентин Андрійович.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Сминтина Валентин Андрійович.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.